04;09;12

Стационарные состояния ВЧ индукционного разряда низкого давления вблизи порога погасания

© А.В. Зыков, К.И. Положий

Харьковский государственный университет

Поступило в Редакцию 4 ноября 1999 г.

Усовершенствована самосогласованная, пространственно усредненная модель ВЧ индукционного разряда низкого давления и показано, что учет размеров приэлектродных слоев приводит к двузначной зависимости равновесной температуры электронов от давления и мощности. Установлено, что существует критическая мощность, зависящая от давления и геометрии рабочей камеры, ниже которой существование стационарного индукционного разряда невозможно. Сравнение полученных теоретических результатов с экспериментальными данными показало хорошее соответствие.

Высокочастотный индукционный (ВЧИ) разряд низкого давления при давлении рабочего газа, когда длина свободного пробега частиц превышет размеры газоразрядной камеры (ГРК), широко используется в вакуумно-плазменных технологиях травления и нанесения покрытий как эффективный источник низкоэнергетичных ионов. Преимущества использования ВЧИ разряда в реакторах ионно-плазменного травления и в источниках ионов обусловлены высокой плотностью плазмы (до 10^{12} сm⁻³), минимальным разбросом ионов по энергиям ($\Delta \varepsilon_1 \leq 5$ eV), относительно низким рабочим давлением ($p = 10^{-4} \div 10^{-3}$ Torr), высокой экономичностью (энергетическая цена иона $\eta \sim (30 \div 80)$ eV), отсутствием накаливаемых узлов и большим ресурсом работы с химически активными газами, возможностью независимого управления энергией и плотностью ионов. Поэтому за последние годы число работ, посвященных экспериментальному и теоретическому изучению природы ВЧИ разряда низкого давления, сильно возросло.

В частности, в работах Ли и Либермана [1-4] получила развитие самосогласованная, пространственно усредненная модель стационарных состояний ВЧИ разряда, позволяющая рассчитывать электронную температуру T_e , плотности ионов n_i и электронов n_e , плотности ионного j_i

68

и электронного j_e токов, импеданс разряда и т. д. в зависимости от внешних условий: размеров и формы ГРК, давления и сорта рабочего газа, поглощаемой в разряде ВЧ мощности *P*. Отметим, что аналогичный подход для определения равновесных параметров плазмы ВЧИ разряда был предложен ранее в работе [5]. В модели предполагается, что разряд ограничен эквипотенциальной поверхностью ГРК, на которой $j_i = j_e$, и состоит из области квазинейтральной плазмы $(n_e \approx n_i)$ с изотропной максвелловской функцией распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ), в которой происходят ионизация и возбуждение рабочего газа и бесстолкновительных пристеночных слоев пространственного заряда $(n_i \gg n_e)$, где сосредоточено основное падение потенциала между плазмой и стенкой. В соответствии со сделанными в модели упрощениями законы сохранения частиц и энергии в интегральной форме для стационарного ВЧИ разряда приобретают вид:

$$n_{a}\nu^{i}(T_{e})\int_{V}n_{e}dV = v_{B}\oint_{S}n_{i}dS$$

$$P = e\varepsilon_{c}(T_{e})\cdot n_{a}\nu^{i}(T_{e})\int_{V}n_{e}dV + e\varepsilon_{T}(T_{e})v_{B}\oint_{S}n_{i}dS,$$
(1)

где интегрирование проводится по объему V и поверхности S области плазмы, e — заряд электрона, ν^i — частота ионизирующих электронатомных соударений, ε_c — средние потери энергии электронов в неупругих соударениях [2] и $\varepsilon_T = T_e(2+0.5\cdot\ln(M_i/m_e))$ — кинетическая энергия, выносимая на стенки ГРК электрон-ионной парой, рассчитанные для максвелловской ФРЭЭ, M_i и m_e — масса электрона, $\nu_B = (2T_e/M_i)^{1/2}$ — скорость ионов на границе плазма-слой, соответствующая критерию Бома.

Усреднение по объему и поверхности плазмы плотностей электронов ионов при линейной аппроксимации зависимости сечения ионизации от энергии электронов [6] позволяет привести уравнения (1) к виду:

$$n_{a}d = \frac{\bar{n}_{i}}{\bar{n}_{e}} \cdot \frac{v_{B}}{\nu^{i}}; \quad \nu^{i}(T_{e}) = C_{i} \cdot (U_{i} + 2T_{e}) \cdot \sqrt{\frac{8T_{e}}{\pi m_{e}}} \cdot \exp\left(-\frac{U_{i}}{T_{e}}\right);$$
$$P_{S} = j_{i} \cdot \eta(T_{e}); \quad \eta = \varepsilon_{c} + \varepsilon_{T}; \quad j_{i} = e \cdot \bar{n}_{i}v_{B}, \qquad (2)$$

где C_i — постоянная сечения ионизации, U_i — потенциал ионизации, d = V/S — геометрический параметр, \bar{n}_e — усредненная по V плотность

электронов, $\bar{n_i}$ — усредненная по *S* плотность ионов, $P_S = P/S$ — удельная мощность, η — энергетическая цена иона. Система уравнений (2) дает решение, при котором T_e не зависит от *P* и однозначно определяется параметром подобия n_ad или pd ($p = n_akT_g$, $T_g = 300$ K) аналогично известному результату для положительного столба тлеющего разряда [6], а n_e , n_i и j_i прямо пропорциональны *P* при постоянном pd.

В широком диапазоне внешних условий эти результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными [7,8], однако не объясняют погасание ВЧИ разряда при снижении давления рабочего газа и мощности. Поэтому представляет интерес развитие данной модели ВЧИ разряда для определения области сущестования стационарных состояний плазмы при предельно низких давлениях рабочего газа и малых удельных мощностях.

Для этого необходимо уточнить физический смысл геометрического параметра d = V/S и, соответственно, параметра подобия pd, который однозначно определяет T_e . Для простоты и наглядности рассмотрим модель бесконечного плоского плазменного конденсатора с расстоянием между электродами $2d_0$ (полученные ниже результаты легко обобщить и на случай цилиндрической и сферической геометрии). При больших концентрациях заряженных частиц толщина приэлектродного слоя пространственного заряда $h \ll d_0$ и область плазмы совпадает с размерами ГРК, а геометрический параметр имеет значение $d \approx d_0$. Однако в предельных случаях низкого давления и малой мощности, а следовательно небольшой плотности плазмы, величина h становится сравнимой с расстоянием между электродами, что необходимо учитывать. В этом случае, размер d определяет полуширину области, занимаемой плазмой, для которого выполняется соотношение $d = d_0 - h$.

Согласно модели в приповерхностных слоях $n_i \gg n_e$, и в качестве уравнения, связывающего параметры плазмы с толщиной слоя h, воспользуемся "законом 3/2" Чайльда–Ленгмюра для тока положительных ионов с начальной скоростью v_B для плоского слоя [6]:

$$h = \left(9\pi\sqrt{M_i/2e}\right)^{-1/2} \left[(M_i v_B^2/2e + \varphi_{sh})^{3/4} - (M_i v_B^2/2e)^{3/4} \right] j_i^{-1/2},$$
$$\varphi_{sh} = \varphi_{pl} - 2T_e, \tag{3}$$

где φ_{sh} — падение потенциала в слое, $\varphi_{pl} = 0.5T_e \ln(M_i/m_e)$ — перепад потенциала плазма-стенка [6], а $2T_e$ — падение потенциала в плазме.



Рис. 1. Численные решения системы уравнений (4) для параметров ВЧИ разряда низкого давления T_e и jd_0^2 в зависимости от внешних параметров pd_0 и $P_Sd_0^2$: I - 2, 2 - 1, 3 - 0.5, 4 - 0.125 ($P_Sd_0^2$, W), $5 - 10^{-2}$, $6 - 10^{-3}$, $7 - 4 \cdot 10^{-4}$, $8 - 2 \cdot 10^{-4}$ (pd_0 , Torr \cdot cm). Пунктиром обозначены кривые для классических зависимостей в предположении $\xi \equiv 0$. Точки на рис. 1, c соответствуют экспериментальным данным для $P_Sd_0^2 = 1$ W.

Тогда, учитывая, что $d = d_0(1 - \xi)$ ($\xi = h/d_0$ — безразмерная толщина слоя), уравнения (2) приобретают вид:

$$n_{a}d_{0} = \frac{\bar{n}_{i}}{\bar{n}_{e}} \cdot v_{B} \cdot \frac{1}{\nu^{i}} \cdot \frac{1}{1-\xi}, \quad P_{S} = j_{i} \cdot \eta(T_{e}),$$

$$\xi = \left(9\pi\sqrt{M_{i}/2e}\right)^{-1/2} \left[(T_{e} + \varphi_{sh})^{3/4} - T_{e}^{3/4} \right] \sqrt{\frac{\eta(T_{e})}{P_{S}d_{0}^{2}}}.$$
 (4)

Численные решения уравнений (4) для зависимости T_e от pd_0 представлены на рис. 1, a семейством графиков при различных значениях $P_Sd_0^2$, а на рис. 1, b — зависимости T_e от $P_Sd_0^2$ при различных pd_0 (рабочий газ аргон, $\bar{n}_e/\bar{n}_i \approx 0.3$, значения газовых постоянных C_i , U_i взяты из работы [6], а зависимость $\varepsilon_c(T_e)$ из [9]). Как следует из графиков на рис. 1, a, учет размеров приэлектродных слоев дает новую, двузначную зависимость $T_e(pd_0)$, которая определяет пороговые значения давления для области существования стационарных состояний плазмы при различных $P_Sd_0^2$. Для сравнения на рис. 1, a пунктиром представлено решение системы (2) для $T_e(pd_0)$, которое является предельным случаем (4) при $\xi \rightarrow 0$.

Параметр $P_S d_0^2$ определяется как поглощаемой разрядом мощностью, так и геометрией ГРК и является, по сути, дополнительным параметром подобия ВЧИ разряда при низких давлениях. Для фиксированных размеров ГРК снижение рабочего давления приводит к росту минимального значения $P_S d_0^2$, при котором возможно стационарное состояние плазмы. График зависимости $(P_S d_0^2)_{cr}$ от $(pd_0)_{cr}$ приведен на рис. 2. Уравнения (4) носят универсальный характер и позволяют рассчитать концентрацию плазмы и плотности тока заряженных частиц для ВЧИ разряда в заданной ГРК, а также их зависимости от внешних параметров системы. Зависимости $j_i d_0^2 (pd_0)$ и $j_i d_0^2 (P_S d_0^2)$ представлены на рис. 1, *с* и *d*.

Для проверки полученных результатов были проведены эксперименты на установке с ВЧИ источником ионов (ИИ) [10], имеющим металлическую ГРК цилиндрической формы (диаметр 250 mm, длина 60 mm) [7], который в первом приближении соответствует модели плоского конденсатора. Обработанные экспериментальные данные для плотности тока и порога погасания разряда в ИИ представлены на рис. 1, *с* и рис. 2. Из графиков следует хорошее качественное соответствие данных эксперимента и теории влизи порога потухания ВЧИ разряда при $pd_0 < 10^{-2}$ Torr. По нашим оценкам, причиной завышенных



Рис. 2. Зависимость критической мощности (мощности погасания ВЧИ разряда) от давления (рабочий газ — аргон). На графике также представлена зависимость безразмерной толщины слоя ξ от давления, соответствующая критической мощности погасания разряда. Точками изображены значения $P_S d_0^2$, полученные из эксперимента.

в 2÷3 раза пороговых значений $(P_S d_0^2)_{cr}$ являются значительные, порядка десятков и сотен ватт, омические потери мощности в индукторе и в согласующем устройстве генератора, а также ВЧ нагрев проводящих элементов ГРК, особеннос в области низких давлений, когда напряжение на индукторе достигает нескольких киловольт, что отмечалось и в работе [11]. Поэтому для более точных измерений необходимо провести специальные калибровочные исследования ВЧ цепей согласно методикам, описанным в [11]. В данном устройстве не наблюдалась

и высокотемпературная ветвь равновесных состояний плазмы, которую предсказывает теория.

Таким образом, в дальнейших исследованиях необходимо как усовершенствовать постановку эксперимента, так и уточнить модель ВЧИ разряда путем поправок на граничные условия, реальные ФРЭЭ [8] и зависимости сечения неупругих процессов от энергии.

Список литературы

- Lee C., Graves D.B., Lieberman M.A., Hess D.W. // J. Electrochem. Soc. 1994. V. 141. P. 1546.
- [2] Lee C., Lieberman M.A. // J. Vac. Sci. Technol. 1995. A. V. 13. P. 368.
- [3] Lieberman M.A., Gottscho R.A. // Physics of Thin Films. 1994. V. 18. (Ed. M. Francombe and J. Vossen. New York: Academic).
- [4] Gudmundson J.T., Lieberman M.A. // Plasma Sources Sci. Technol 1998. V. 7. P. 83–95.
- [5] Бондаренко В.Г., Денисов В.П., Еремин Б.Г. и др. // Физика плазмы. 1991.
 Т. 17. В. 6. С. 756.
- [6] Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987. 592 с.
- [7] Дудин С.В., Зыков А.В., Положий К.И. // Письма в ЖТФ. 1998. Т. 24. № 22.
- [8] Godyak V.A., Piejak R.B., Alexandrovich B.M. // Plasma Sources Sc. Technol. 1995. V. 4. P. 332–336.
- [9] Lieberman M.A., Ashida S. // Plasma Sources Sci. Technol. 1996. V. 5. P. 145-158.
- [10] *Будянский А.М., Зыков А.В., Фареник В.И.* Высокочастотный источник ионов. Патент Украины № 2426. Патент РФ № 1570549 от 28.06.93.
- [11] Suzuki K. et al. // Plasma Sources Sci. Technol. 1998. V. 7. P. 13-20.